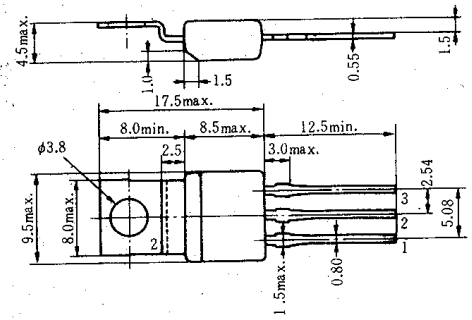
2SB717, 2SB718

シリコン PNP エピタキシャル形

低周波高電圧増幅用
2SD757, 2SD758 とコンプリメンタリペア

SILICON PNP EPITAXIAL

LOW FREQUENCY HIGH VOLTAGE AMPLIFIER
Complementary pair with 2SD757 and 2SD758



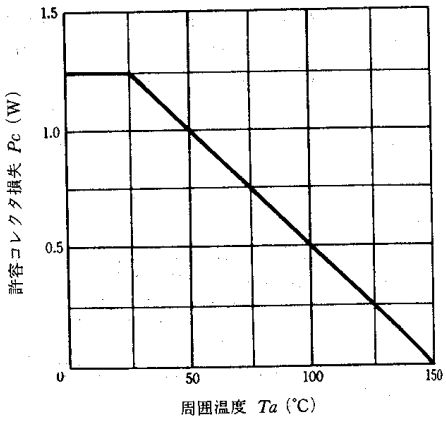
1. ベース：Base
2. コレクタ：Collector
3. エミッタ：Emitter
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-202AA MOD.)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	2SB717	2SB718	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	−160	−200	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	−160	−200	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	−5	−5	V
コレクタ電流	I_C	−50	−50	mA
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	−100	−100	mA
許容コレクタ損失	P_C	1.25	1.25	W
接合部温度	T_j	150	150	℃
保存温度	T_{stg}	−45～+150	−45～+150	℃

許容コレクタ損失の周囲温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	2SB717 min.	2SB717 typ.	2SB717 max.	2SB718 min.	2SB718 typ.	2SB718 max.	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	I_C=−10μA, I_E=0	−160	—	—	−200	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	I_C=−1mA, R_{BE}=∞	−160	—	—	−200	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	I_E=−10μA, I_C=0	−5	—	—	−5	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	V_{CB}=−140V, I_E=0	—	—	−10	—	—	—	μA
		V_{CB}=−160V, I_E=0	—	—	—	—	—	−10	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}*	V_{CE}=−5V, I_C=−10mA	60	—	320	60	—	320	
直流電流増幅率	h_{FE2}	V_{CE}=−5V, I_C=−1mA	30	—	—	30	—	—	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	V_{CE}=−5V, I_C=−10mA	—	—	−1.5	—	—	−1.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=−30mA, I_B=−3mA	—	—	−2	—	—	−2	V
利得帯域幅積	f_T	V_{CE}=−5V, I_C=−10mA	—	140	—	—	140	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	V_{CB}=−10V, I_E=0, f=1MHz	—	5.5	—	—	5.5	—	pF

*2SB717, 2SB718 は h_{FE1} の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。
*The 2SB717 and 2SB718 are grouped by h_{FE1} as follows.

B	C	D
60～120	100～200	160～320

HITACHI